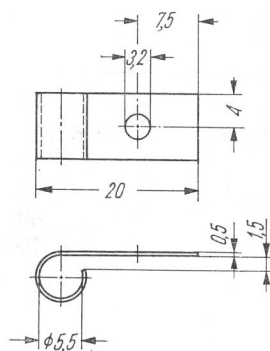


Rys. 1-101. ACY33



Rys. 1-102. Płytką chłodząca

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: SIEMENS

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy w obudowie metalowej TO-1, wyprowadzenia elektrycznie odizolowane od obudowy, wyprowadzenie kolektora oznaczone na obudowie czerwonym punktem, do umocowania na chassis przewidziana jest płytka chłodząca, ciężar ok. 1 G

Zastosowanie: stopnie wzбудzające i końcowe m.cz. średniej mocy, do układów przeciwnobnych dobierane parami.

Typy podobne: OC75(Ph), GC518 (Tes)

Wartości charakterystyczne¹⁾

$-I_{CB0}$	< 10	μA	przy $-U_{CB0} = 10 V$
$-I_{CES}$	< 50	μA	przy $-U_{CES} = 32 V, U_{BE} \geq 1 V$
$-I_{CES}$	< 330	μA	przy $-U_{CES} = 32 V, U_{BE} \geq 1 V, t_{amb} = 60^\circ C$
$-I_{CB0}$	< 50	μA	przy $-U_{CB0} = 32 V$
$-I_{CB0}$	< 330	μA	przy $-U_{CB0} = 32 V, t_{amb} = 60^\circ C$
$-I_{EBO}$	< 50	μA	przy $-U_{EBO} = 10 V$
$-I_{EBO}$	< 280	μA	przy $-U_{EBO} = 10 V, t_{amb} = 60^\circ C$
$-U_{BE}$	0,22 (< 0,3)	V	przy $U_{CB} = 0, -I_C = 50 mA$
$-U_{BE}$	0,32 (< 0,45)	V	przy $U_{CB} = 0, -I_C = 300 mA$
$-U_{BE}$	0,43 (< 0,70)	V	przy $U_{CB} = 0, -I_C = 1000 mA$
$h_{21E}(V)$	66		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 50 mA$
	75(50÷100)		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 300 mA$
	68		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 1000 mA$
$h_{21E}(VI)$	97		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 50 mA$
	110(75÷150)		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 300 mA$
	100		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 1000 mA$
$h_{21E}(VII)$	167		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 50 mA$
	190(125÷250)		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 300 mA$
	173		przy $U_{CB} = 0, -I_C = 1000 mA$
$-U_{CE sat}$	0,16 (< 0,5)		przy $I_C = 1 A, h_{21E} = 20$
f_T	1,5 (> 1)	MHz	przy $-I_C = 10 mA, -U_{CE} = 2 V$
f_{hfe}	15 (> 10)	kHz	przy $-I_C = 10 mA, -U_{CE} = 2 V$
$r_{bb'}$	25	Ω	przy $-I_C = 1 mA, -U_{CE} = 5 V$
C_{CB0}	100	pF	przy $-U_{CB0} = 5 V$
$G_p(500 mA)$			
$G_p(max)$	0,6 (> 0,5)		przy $U_{CC} = 10 V, R_{CC} = 16 \Omega$ $I_C = 500 mA$

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ C$

ACY33

Warunek dobierania tranzystorów parami

$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}}$	1,1(< 1,25)	przy $-I_C = 50 \text{ mA}$, $U_{CB} = 0$
$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}}$	1,1(< 1,25)	przy $-I_C = 300 \text{ mA}$, $U_{CB} = 0$

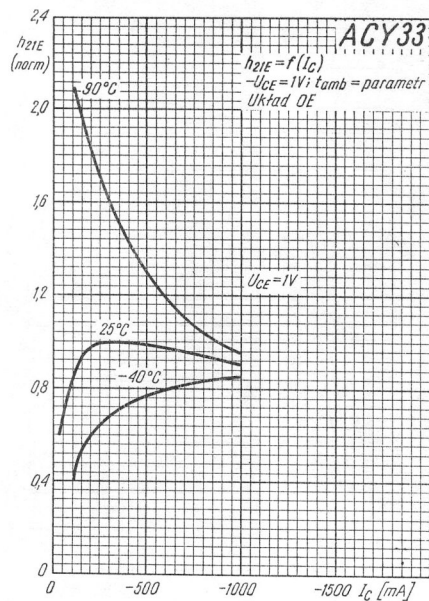
Wartości graniczne

$-U_{CES \text{ max}}$	32	V	$t_{j \text{ max}}$	90	°C
$-U_{CER \text{ max}}$	32 ²⁾	V	t_{stg}	$-55 \div +75$	°C
$-U_{CB0 \text{ max}}$	32	V	$P_{tot \text{ max}}$	1100 ³⁾	mW
$-U_{EB0 \text{ max}}$	10	V	$R_{th j-a \text{ max}}$	300	°C/W
$-I_C \text{ max}$	1000	mA	$R_{th j-c \text{ max}}$	40	°C/W
$-I_B \text{ max}$	200	mA	$R_{th j-a \text{ max}}$	104 ⁴⁾	°C/W

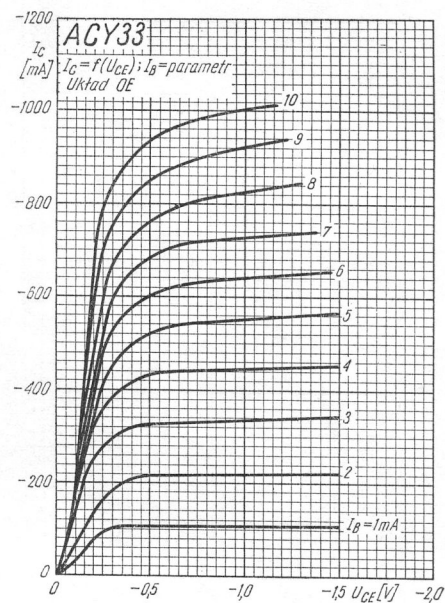
²⁾ $R_{BE} \leq 500 \ \Omega$

³⁾ $t_{case} \leq 45^\circ\text{C}$

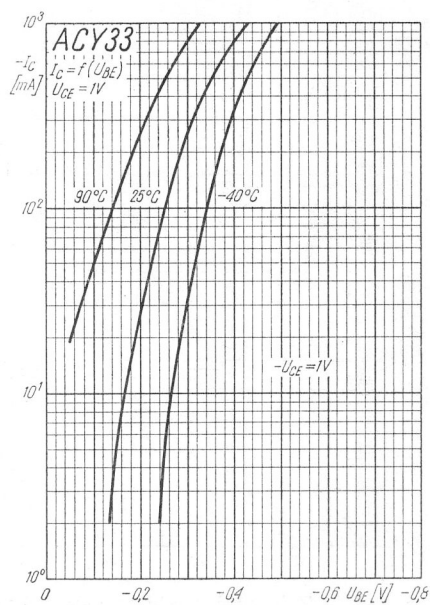
⁴⁾ z płytką chłodzącą



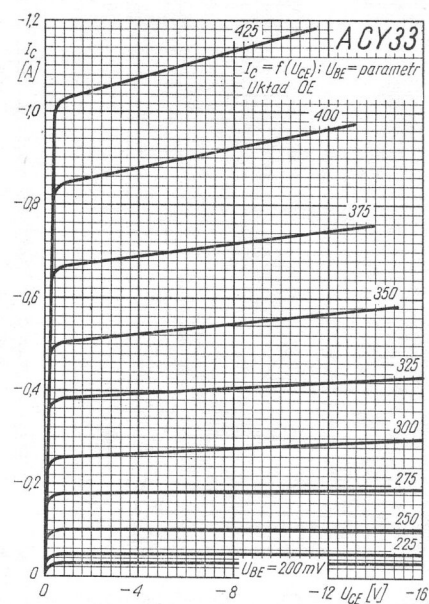
Rys. 1-103. Zależność normowanego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



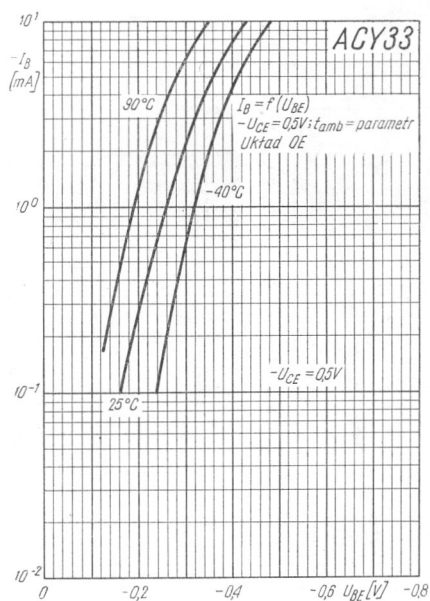
Rys. 1-104. Charakterystyki wyjściowe



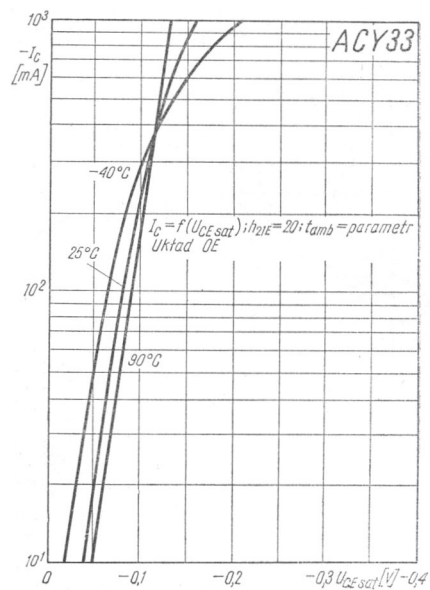
Rys. 1-105. Charakterystyki sterowania napięciowego



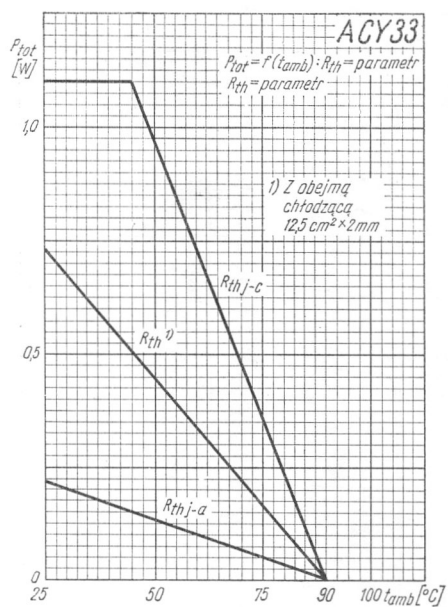
Rys. 1-106. Charakterystyki wyjściowe



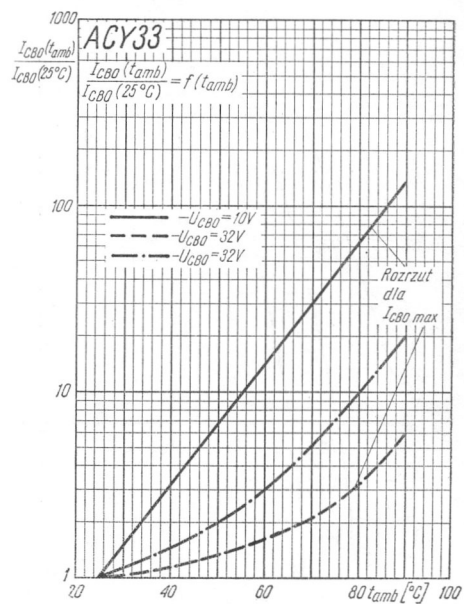
Rys. 1-107. Charakterystyki wejściowe



Rys. 1-108. Zależność prądu kolektora od napięcia nasycenia kolektora



Rys. 1-109. Charakterystyka dopuszczalnej mocy strat w zależności od temperatury otoczenia



Rys. 1-110. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury otoczenia